

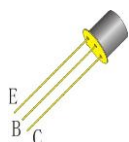
3CG1 型硅 PNP 高频小功率晶体管

1、特性

芯片采用硅外延平面结构，器件采用 A3-01B 型金属封装和 SMD-0.2、UB 型金属陶瓷封装。

器件具有特征频率高、体积小、重量轻，可靠性高的特点。

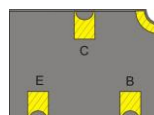
器件的静电放电敏感度为 4000V，A3-01B 典型重量 0.35g，SMD-0.2 典型重量 0.45g，UB 典型重量 0.04g。



A3-01B 型



SMD-0.2 型



UB 型

注：SMD-0.2 封装产品型号后缀加“U”标识，UB 封装产品型号后缀加“UB”标识。

2、质量等级及执行标准

G、G+:Q/RBJ1100 (A3-01B 型)，Q/RBJ1001QZ (SMD-0.2、UB 型)，QZJ840611；

JP、JT、JCT (A3-01B 型)：ZZR-Q/RBJ20014-2002, GJB33A-1997；

JCT/K (A3-01B 型)：Q/RBJ22014H1-2006, GJB33A-1997；

CAST (A3-01B 型)：CASTPS10/217-2006, GJB33A-1997；

YA、YB、YC (A3-01B 型)：Q/QJA 20104/38-2017, Q/QJA 20104A-2017。

3、最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

型 号	$P_{\text{tot1}}^{\text{a}}$ mW	$P_{\text{tot2}}^{\text{b}}$ mW	I_{CM} mA	V_{CBO} V	V_{CEO} V	V_{EBO} V	$T_{\text{stg}} , T_{\text{j}}$ °C
3CG1A	300	1000	40	-20	-15	-4	-55~175
3CG1B				-30	-25		
3CG1C				-40	-30		
3CG1D				-50	-40		
3CG1E				-60	-50		
a P_{Tot1} 为 $T_{\text{A}}=25^{\circ}\text{C}$，不加散热片时的最大额定功率；$T_{\text{A}}>25^{\circ}\text{C}$时,按 $2.0\text{mW}/^{\circ}\text{C}$线性地降额。 b P_{Tot2} 为 $T_{\text{C}}=25^{\circ}\text{C}$时的最大额定功率；$T_{\text{C}}>25^{\circ}\text{C}$时,按 $6.67\text{mW}/^{\circ}\text{C}$线性地降额。							

4、主要电特性

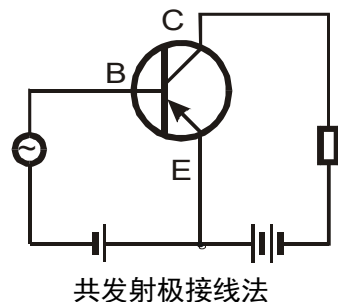
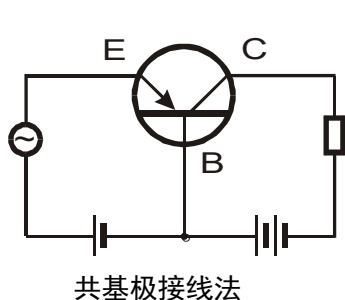
主要电特性（除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

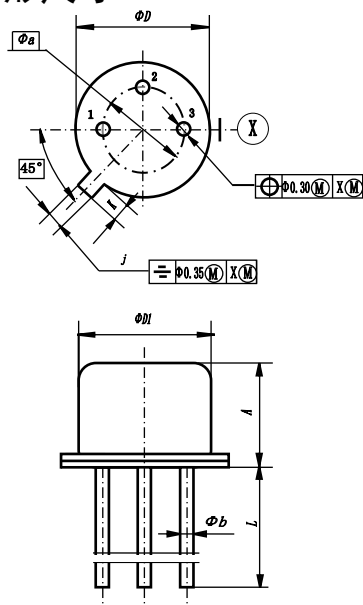
参 数		数 值			单 位
符 号	测试条件	最小值	典型值	最大值	
$V_{(BR) CBO}$	$I_C=0.1mA$	-20	—	—	V
$V_{(BR) CEO}$	$I_C=0.1mA$	-15	—	—	V
$V_{(BR) EBO}$	$I_E=0.1mA$	-4	—	—	V
I_{CBO}	$V_{CB}=-10V$	—	0.02	0.1	μA
I_{CEO}	$V_{CE}=-10V$	—	0.05	0.5	μA
I_{EBO}	$V_{EB}=-2V$	—	0.02	0.1	μA
h_{FE}	$V_{CE}=-10V, I_C=5mA$	25	—	—	—
$V_{BE(sat)}$	$I_C=10mA, I_B=1mA$	—	-0.8	-1.0	V
$V_{CE(sat)}$	$I_C=10mA, I_B=1mA$	—	-0.1	-0.3	V
f_T	$V_{CE}=-10V, I_C=5mA, f=30MHz$	100	200	—	MHz
C_{ob}	$V_{CB}=-10V, I_E=0, f=1MHz$	—	3.5	5	pF

5、典型电路应用图

器件在电子线路中主要有两种接线法，如图所示：



6、外形尺寸



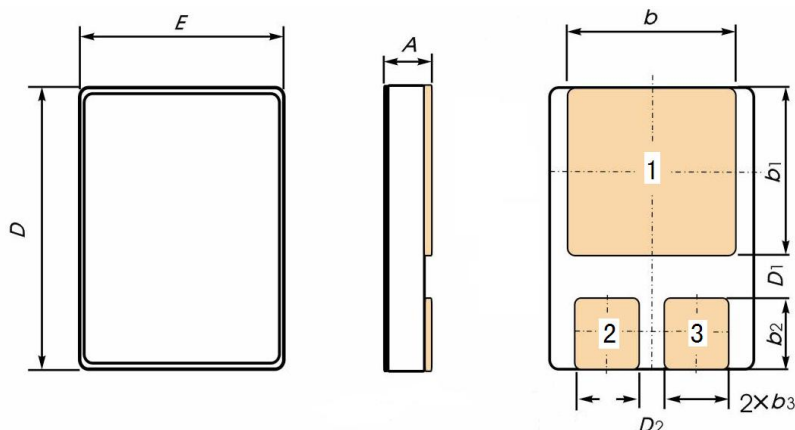
单位为毫米

尺寸符号	数值		
	最小值	典型值	最大值
A	4.32	—	5.33
Φa	—	2.54	—
Φb	0.407	—	0.508
ΦD	5.31	—	5.84
ΦD_1	4.53	—	4.95
j	0.92	1.04	1.16
K	0.51	—	1.21
L	12.5	—	25.0

引出端极性：1—发射极，2—基极，3—集电极

A3-01B 外形尺寸

单位为毫米

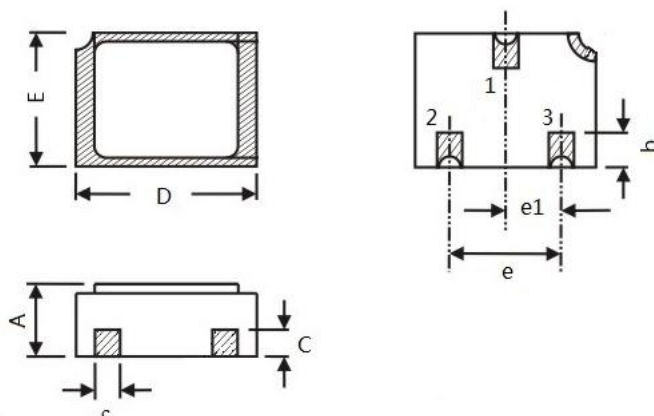


引出端极性：1—集电极，2—发射极，3—基极

SMD-0.2 外形尺寸

尺寸符号	数值	
	最 小 值	最 大 值
<i>A</i>	2.41	3.34
<i>b</i>	4.85	5.45
<i>b</i> ₁	4.40	5.15
<i>b</i> ₂	1.75	2.15
<i>b</i> ₃	1.85	2.25
<i>D</i>	7.77	8.13
<i>D</i> ₁	0.50	—
<i>D</i> ₂	0.60	—
<i>E</i>	5.23	5.64

单位为毫米



引出端极性：1—集电极，2—发射极，3—基极

UB 外形尺寸

尺寸符号	数 值	
	最小值	最大值
<i>A</i>	1.12	1.47
<i>b</i>	0.56	0.96
<i>C</i>	0.43	0.89
<i>c</i>	0.35	0.67
<i>D</i>	2.82	3.35
<i>E</i>	2.16	2.74
<i>e</i>	1.76	2.07
<i>e</i> ₁	0.85	1.02

7、使用和维护

7.1 器件的安装

安装质量的好坏对器件的可靠性影响很大。

A3-01B 型封装，引出端直径 0.407mm~0.508mm。在安装、测试等过程中不允许多次折弯和施应力，否则易造成引脚折断或玻璃绝缘子裂缝，影响其密封性。SMD-0.2、UB 型金属陶瓷封装，在安装、测试等过程中轻拿轻放，避免碰撞、重物碾压，否则易造成陶瓷金属裂缝，影响其密封性。

焊接安装时，器件允许耐焊接热的条件是温度 260℃ 下不超过 10 秒；浸锡温度不超过 260℃，时间不超过 10 秒。

7.2 器件的使用

测试或筛选时应严格按照规定条件、方法进行，应使用合格的设备、仪器仪表，并对其进行校验；操作人员必须持证上岗，必要时要进行专门培训。

严禁超规范使用，注意防潮、防尘，严禁裸手直接接触器件。

测试设备、仪器仪表可靠接地。

测试过程中应采取静电防护措施。

如发生不可预期情况或误操作造成器件损坏等情况，请与供应商联系。